

S1NBB80**800V 1A****特長**

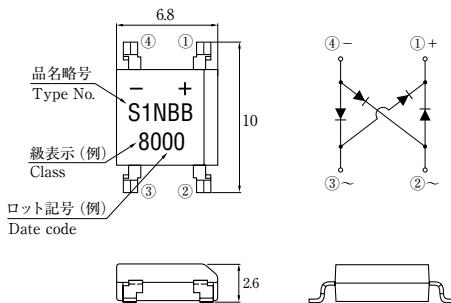
- ・小型 DIP パッケージ
- ・端子間 3.4mm

Feature

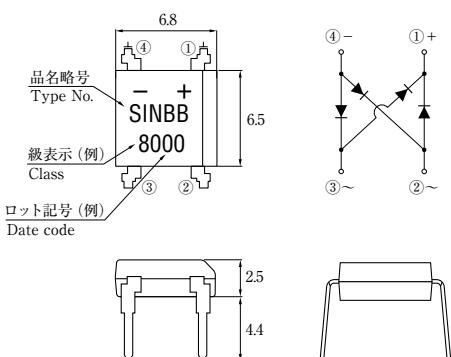
- ・Small-DIP
- ・Pin-distance 3.4mm for isolation

■外観図 OUTLINE

Package : 1NA

Unit : mm
Weight : 0.29g (typ.)

Package : 1NA

Unit : mm
Weight : 0.29g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_f = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1NBB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T _a = 26°C *1 T _a = 25°C *2	1 0.84	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j = 25°C		50	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, T _j = 25°C, 1 素子当たりの規格値 per diode		6	A ² s

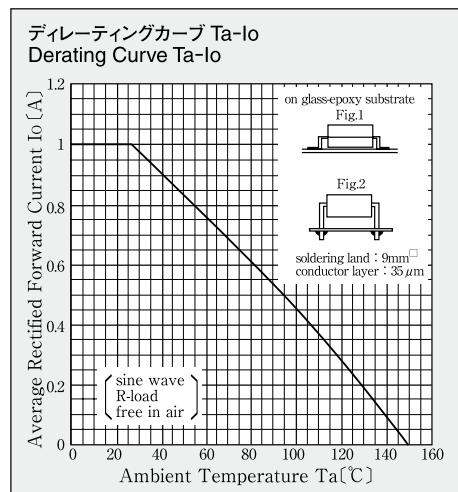
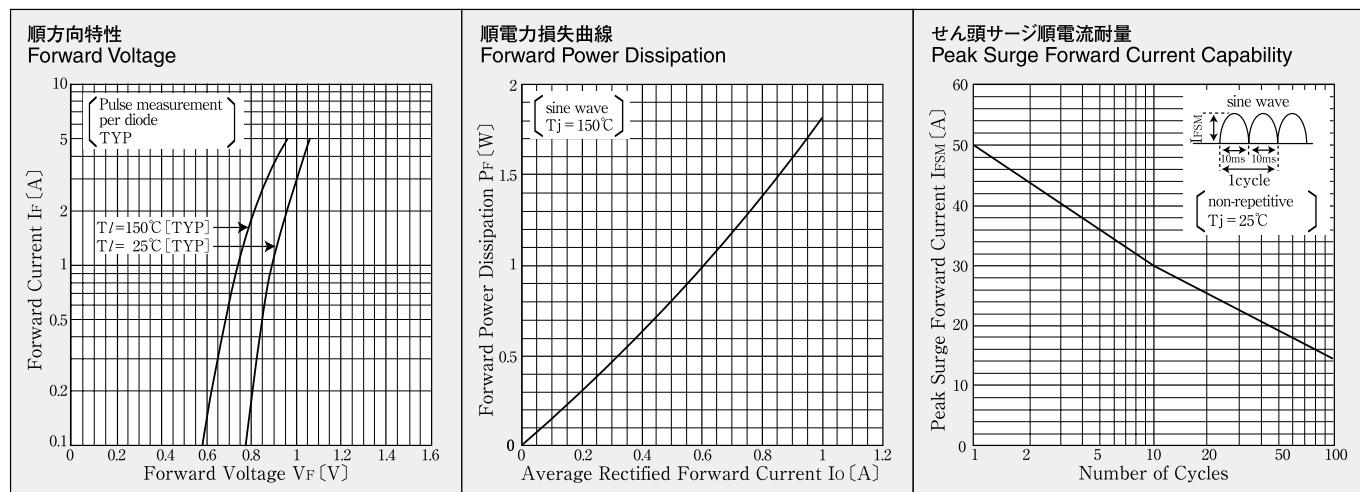
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_f = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _f = 0.5A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 15	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	*1 MAX 68 *2 MAX 84	

*1 : プリント基板実装, 銅箔パターン 324mm²
On glass-epoxy substrate, copper soldering pad area 324mm²

*2 : プリント基板実装, 銅箔パターン 101mm²
On glass-epoxy substrate, copper soldering pad area 101mm²

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.